

BEST AVAILABLE COPY**Method for manufacturing a surface grating with a predetermined lattice constant in a lower surface region of a mesa structure****Patent number:** EP0240776**Publication date:** 1987-10-14**Inventor:** MARZ REINHARD DR; HEISE GERHARD DIPLO-PHYS**Applicant:** SIEMENS AG [DE]**Classification:**- **international:** G02B5/18; H01L21/308; H01S3/06- **european:** G02B5/18E; G02B5/18M2; H01L21/306B4B; H01L21/308D; H01S5/12**Application number:** EP19870103785 19870316**Priority number(s):** DE19863610333 19860326**Also published as:**

JP62232129 (A)

Cited documents:

JP60066485



JP59127895



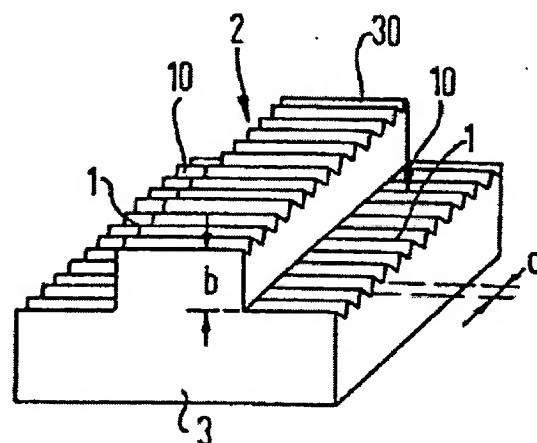
JP59126693



JP60111488

Abstract of EP0240776

The method specified for manufacturing a surface grating (1) with a predetermined lattice constant (a) in a lower surface region (10) of a mesa structure (2), created on the surface of a substrate (3) of a semiconductor material by wet-chemical etching by means of a mask is particularly simple and very cheap. For this purpose, the mesa structure (2) is etched into a finely structured surface of the substrate (3), having a surface grating (4) with the predetermined lattice constant (a), by means of an anisotropic etching agent, which was previously used for producing the surface grating (4). This surface grating (4) in a mask-free region (20), which defines the lower surface region (10) of the mesa structure (2), is thereby transferred depthwise in unchanged form.

FIG 2

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)



⑯ Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

⑪ Veröffentlichungsnummer:

0 240 776
A1

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑯ Anmeldenummer: 87103785.9

⑮ Int.Cl.: G 02 B 5/18
H 01 L 21/308, H 01 S 3/06

⑯ Anmeldetag: 16.03.87

⑯ Priorität: 26.03.86 DE 3610333

⑯ Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft Berlin und
München
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 München 2(DE)

⑯ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
14.10.87 Patentblatt 87/42

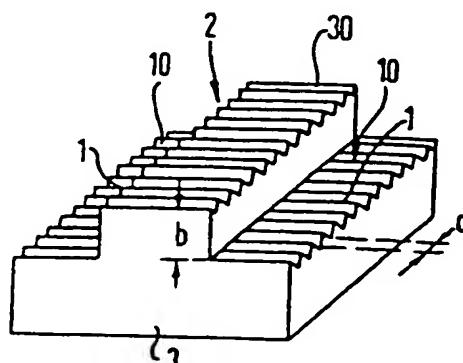
⑯ Erfinder: März, Reinhard, Dr.
Comeniusstrasse 4,
D-8000 München 80(DE)

⑯ Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

⑯ Erfinder: Heise, Gerhard, Dipl.-Phys.
Bert-Brecht-Allee 10
D-8000 München 83(DE)

⑯ Verfahren zur Herstellung eines Oberflächengitters mit einer bestimmten Gitterkonstanten auf einem tieferliegenden Oberflächenbereich einer Mesastruktur.

FIG 2



Siemens Aktiengesellschaft
Berlin und München

Unser Zeichen
VPA 85 P 1257 E 01

5 Verfahren zur Herstellung eines Oberflächengitters mit
einer bestimmten Gitterkonstanten auf einem tieferlie-
genden Oberflächenbereich einer Mesastruktur

10 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur
Herstellung eines Oberflächengitters mit einer bestim-
mten Gitterkonstanten auf einem tieferliegenden Ober-
flächenbereich einerstufigen Struktur nach dem Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1.

15 Für die Realisierung eines DFB-MCRW-Lasers in Ein-
schrittepitaxie ist es notwendig, Gitter in einem
tieferliegenden Bereich unmittelbar neben einem erhabe-
nen Bereich einer Mesastruktur herzustellen. Ein DFB-
MCRW-Laser und seine Herstellung in Einschrittepitaxie
20 ist in der älteren Patentanmeldung P 34 37 209.1 mit dem
Titel "Verbesserung zu einem Monomoden-Diodenlaser" vor-
geschlagen.

25 Denkbar wäre es, das Oberflächengitter auf dem
tieferliegenden Bereich durch ein Verfahren mit Mehr-
lagenmaskierung herzustellen. Dabei muß aber das Pro-
blem umgangen werden, daß Fotolack auf Substrate bzw.
Wafer mit Mesastrukturen nicht aufgeschleudert werden
kann.

30 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein beson-
ders einfaches und sehr billiges Verfahren der eingangs
genannten Art anzugeben.

35 Diese Aufgabe wird gemäß dem kennzeichnenden Teil des
Patentanspruchs 1 dadurch gelöst, daß die stufige Struk-
Ed 1 Sti/26.03.1986

tur in eine fein strukturierte, ein Oberflächengitter mit der bestimmten Gitterkonstanten aufweisende Oberfläche des Substrats mittels eines anisotropen, in zumindest einer zur feinstrukturierten Oberfläche 5 schrägen Richtung am langsamsten ätzenden Ätzmittels geätzt wird, wobei in einem den tieferliegenden Oberflächenbereich der stufigen Struktur definierenden maskenfreien Bereich das Relief des dem anisotropen Ätzmittel ausgesetzten Oberflächengitters der maskierten 10 feinstrukturierten Oberfläche mehr oder weniger formgetreu aber unter Beibehaltung der bestimmten Gitterkonstanten in die Tiefe übertragen wird, wo es nach Beendigung des Ätzvorganges das gewünschte Oberflächengitter bildet.

15

Das erfindungsgemäße Verfahren ist selbstjustierend. Das Oberflächengitter der feinstrukturierten Oberfläche des Substrats muß nur der Bedingung genügen, daß seine Gitterkonstante mit der Gitterkonstanten des gewünschten 20 Oberflächengitters auf dem tieferliegenden Oberflächenbereich übereinstimmt. Ansonsten kann das Profil der Rillen des Oberflächengitters der feinstrukturierten Oberfläche des Substrats weitgehend eine beliebige Form aufweisen. Dieses Gitter kann beispielsweise schwach 25 wellig ausgebildet sein oder aber auch ein rechteckförmiges Rillenprofil aufweisen.

Vorteilhaft ist es aber, wenn gemäß dem Patentanspruch 2 das Oberflächengitter der feinstrukturierten Oberfläche 30 des Substrats durch naßchemisches Ätzen mit zumindest im wesentlichen dem gleichen anisotropen Ätzmittel hergestellt wird, wie es beim Ätzen der stufigen Struktur verwendet wird. In diesem Fall hat das Oberflächengitter der feinstrukturierten Oberfläche des Substrats bereits 35 von vorneherein das gleiche Rillenprofil, wie das gewünschte Oberflächengitter. Das Oberflächengitter der

- 3 - VPA 85 P 1257 E 01

feinstrukturierten Oberfläche des Substrats wird in diesem Fall im wesentlichen unverändert in die Tiefe übertragen, wodurch eine sehr gute Reproduzierbarkeit des Gitters auf dem tieferliegenden Oberflächenbereich 5 erhalten werden kann.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren bleiben die von der Maske abgedeckten Bereiche der strukturierten Oberfläche als erhabene Bereiche stehen, die durch einen Stufen- 10 Übergang von den tieferliegenden Bereichen getrennt sind. Der Begriff "stufige Struktur" ist allgemein so aufzufassen, daß die Struktur Stufen aufweist. Unter der Maske, die auf dem Relief der feinstrukturierten Oberfläche dicht aufliegt, so daß in die von ihr abgedeckten 15 feinstrukturierten Oberflächenbereiche von der Seite her kein Ätzmittel eindringen kann, bleibt das Oberflächengitter der feinstrukturierten Oberfläche stehen, mit der das in die Tiefe abgesenkte Oberflächengitter die gleiche Phasenlage aufweist. Dieses stehengebliebene Ober- 20 flächengitter auf den erhabenen Bereichen der gestuften Struktur kann im Fall des MCRW-Lasers, wo dieser er- habene Bereich streifenförmig ausgebildet ist, zur Gaikopplung verwendet werden, da über den sich räumlich ändernden Übergangswiderstand eine Modulation des In- 25 jektionsstromes stattfindet.

Die Erfindung wird beispielhaft anhand der Figuren in der folgenden Beschreibung näher erläutert. Von den Figuren zeigen:

30 Figur 1 in perspektivischer Darstellung ein Substrat mit einer feinstrukturierten Oberfläche in Form eines Oberflächengitters mit im Profil dreieckförmigen Rillen, das zur Herstellung einer Mesastruktur mit einer streifenförmigen Ätzmaske abgedeckt ist, und 35

Figur 2 das Gebilde nach Figur 1 in der gleichen Darstellung nach dem Ätzen der stufigen Struktur.

5 Die durch die Figuren angedeutete relativ einfache stufige Struktur bezieht sich auf die Herstellung eines MCRW-Lasers, der im wesentlichen nur einen streifenförmigen erhabenen Bereich benötigt. Selbstverständlich kann das Verfahren auch für kompliziertere stufige Strukturen verwendet werden.

10 Zur Herstellung der feinstrukturierten Oberfläche 40 nach Figur 1 wird beispielsweise so vorgegangen, daß in die Oberfläche eines Wafers 3 mit den für die spätere Verwendung erforderlichen epitaktischen Schichtsystem, die in den Figuren nicht dargestellt sind, naßchemisch mit einem anisotropen Ätzmittel ein Oberflächengitter 4 mit im Profil V-förmigen Rillen geätzt wird, und zwar durch Freilegen der (111)-Flächen des Kristallmaterials des Substrats unter der Oberfläche 40. 20 Dieses Oberflächengitter 4 erstreckt sich über die ganze Oberfläche 40 und weist die Gitterkonstante a auf. Als Maske wird Fotolack verwendet, der mittels eines Interferenzmusters belichtet wird.

25 Zur Herstellung der stufigen Struktur 2 nach Figur 2 mit dem streifenförmigen erhabenen Bereich 30 wird auf das Oberflächengitter 4 erneut Fotolack aufgetragen, so, daß er auf dem Relief dieses Gitters überall dicht aufliegt. Durch Maskenbelichtung wird ein Fotoresist-Streifen 5 erzeugt, dessen Längsrichtung quer, beispielsweise senkrecht, zu den Rillen des Oberflächengitters 4 verläuft, und unter dem der erhabene Bereich 30 entsteht. Die übrigen Bereiche 20 des Oberflächengitters 4, die an die Längsseiten des Fotoresist-Streifens 5 grenzen, werden ganz freigelegt, damit bei der Herstellung der stufigen Struktur 2 das Ätzmittel ungehindert auf diese Bereiche

20 einwirken kann. Dabei wird die Oberfläche 40 mit dem darauf befindlichen Fotoresist-Streifen 5 mit dem gleichen Ätzmittel wie bei der Herstellung des Oberflächen-
5 gitters 4 geätzt. Dadurch wird dieses Gitter in den Bereichen 20 seitlich neben dem Fotoresist-Streifen 5 unverändert in die Tiefe übertragen. Es entstehen die tieferliegenden Oberflächenbereiche 10 mit den gewünschten Oberflächengittern 1, die an den dazwischenliegenden streifenförmigen erhabenen Bereich 30 grenzen, auf dem
10 der Rest des Oberflächengitters 4 nach Figur 1 stehen-
geblieben ist. Das stehengebliebene Gitter und die Git-
ter 1 auf den tieferliegenden Bereichen 10 haben die gleiche Phasenlage und die gleiche Gitterkonstante a.

15 Für die Realisierung einer solchen stufigen Struktur 2 kann beispielsweise ein Substrat 3 aus GaAs oder GaAlAs mit einem Ätzmittel geätzt werden, das aus einer Mi-
schung aus Schwefelsäure, Wasserstoffperoxid und Was-
ser besteht. Bei einer praktischen Realisierung einer
20 Struktur 2 wurde ein Substrat 3 aus GaAs oder aus einer GaAlAs mit einem Ätzmittel geätzt, das aus etwa 0,75 bis 3 Teilen konzentrierter Schwefelsäure, 8 Teilen 30%igem Wasserstoffperoxid und aus 35 Teilen Wasser bestand. Die Prozentangabe versteht sich als Volumenprozent.

25 Zur Herstellung des Oberflächengitters 4 wurde die Ober-
fläche des Substrats etwa 1 Minute lang mit diesem Ätz-
mittel geätzt, und zur Herstellung der stufigen Struktur 2 wurde etwa 1 - 5 Minuten lang geätzt, wobei die Versenk-
30 tiefe b von 0,2 - 1,4 μm beträgt. Die Gitterkonstante a lag im Submikronbereich etwa bei 0,3 μm . Günstig ist es, die Ätzvorgänge bei niedrigen Temperaturen, beispiels-
weise bei oder in der Nähe von 0°C vorzunehmen.

- 6 - VPA 85 P 1257 E 01

Vorzugsweise wird eine stufige Struktur 2 auf einem Substrat 3 aus InP oder aus einem quarternären Material auf InP-Basis, beispielsweise aus InGaAsP erzeugt. Als Ätzmittel ist anstelle der obengenannten Mischung eine Ätzmischung aus 10 Teilen 48%igem HBr, einem Teil gesättigten Bromwassers und 40 Teilen Wasser geeignet, wobei sich auch hier die Prozentangabe als Volumenprozent versteht. Diese Mischung mit dem angegebenen oder einem ähnlichen Mischungsverhältnis erzeugt V-förmig gefurchte Gitter, die mit dieser Mischung wie oben angegeben in die Tiefe übertragen werden können.

2 Patentansprüche

2 Figuren

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Oberflächengitters

(1) mit einer bestimmten Gitterkonstanten (a) auf einem

5 tieferliegenden Oberflächenbereich (10) einer auf der Oberfläche eines Substrats (3) aus einem Kristallmaterial durch naßchemisches Ätzen mittels Maske erzeugten stufigen Struktur (2), insbesondere einer Mesastruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die 10 stufige Struktur (2) in eine feinstrukturierte, ein Oberflächengitter (4) mit der bestimmten Gitterkonstanten (a) aufweisende Oberfläche (40) des Substrats (3) mittels eines anisotropen, in zumindest einer zur feinstrukturierten Oberfläche (40) schrägen Richtung am 15 langsamsten ätzenden Ätzmittels geätzt wird, wobei in einem den tieferliegenden Oberflächenbereich (10) der stufigen Struktur (2) definierenden maskenfreien Bereich (20) das Relief des dem anisotropen Ätzmittel ausgesetzten Oberflächengitters (4) der maskierten, feinstrukturierten Oberfläche (40) mehr oder weniger formgetreu 20 aber unter Beibehaltung der bestimmten Gitterkonstanten (a) in die Tiefe übertragen wird, wo es nach Beendigung des Ätzvorganges das gewünschte Oberflächengitter (1) bildet, und wobei das Substrat aus InP oder einem 25 quarternären Material auf InP-Basis und das anisotrope Ätzmittel aus einer Mischung aus HBr, gesättigtem Bromwasser und Wasser besteht, oder wobei das Substrat aus GaAs oder GaAlAs und das anisotrope Ätzmittel aus einer 30 Mischung aus H_2SO_4 , H_2O_2 und Wasser besteht.

30 2. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Oberflächengitter (4) der feinstrukturierten Oberfläche (40) des Substrats (3) durch naßchemisches Ätzen mit zumindest im wesentlichen dem gleichen anisotropen Ätzmittel hergestellt wird, wie es beim Ätzen der stufigen Struktur (2) verwendet wird.

1/1

FIG 1

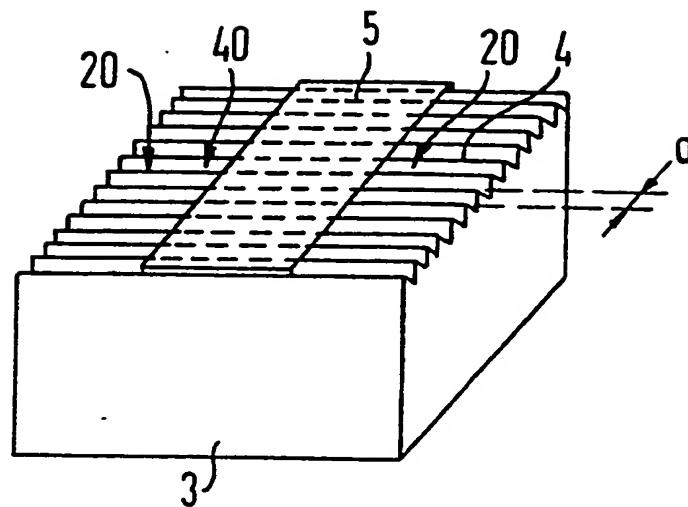
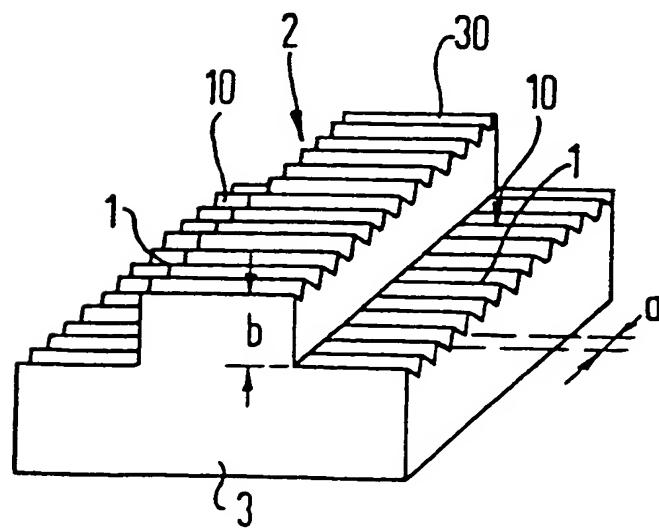


FIG 2





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0240776

Nummer der Anmeldung

EP 87 10 3785

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE					
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)		
Y	APPLIED PHYSICS LETTERS, Band 28, Nr. 1, 1. Januar 1976, Seiten 44-46, American Institute of Physics, New York, US; W.-T. TSANG et al.: "Profile and groove-depth control in GaAs diffraction gratings fabricated by preferential chemical etching in H ₂ SO ₄ -H ₂ O ₂ -H ₂ O system" * Seite 44 *	1	G 02 B 5/18 H 01 L 21/308 H 01 S 3/06		
Y	---	1			
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 9, Nr. 201 (E-336)[1924], 17. August 1985; & JP-A-60 66 485 (TOSHIBA K.K.) 16-04-1985 * Zusammenfassung *	1			
A	---	1			
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 8, Nr. 256 (E-280)[1693], 22. November 1984; & JP-A-59 127 895 (FUJIKURA DENSEN K.K.) 23-07-1984 * Zusammenfassung *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int. Cl. 4) H 01 S H 01 L G 02 B		
A	---	1			
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 8, Nr. 250 (E-279)[1687], 16. November 1984; & JP-A-59 126 693 (FUJIKURA DENSEN K.K.) 21-07-84 * Zusammenfassung *	1			
	---	-/-			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.					
Recherchenort DEN HAAG	Abschlußdatum der Recherche 09-07-1987	Prüfer GNUGESSER H. M.			
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze					
E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument					



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 10 3785

Seite 2

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 9, Nr. 266 (E-352) [1989], 23. Oktober 1985; & JP-A-60 111 488 (KOGYO GIJUTSUIN JAPAN) 17-06-1985 * Zusammenfassung *</p> <p>-----</p>	1	<p>RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int. Cl. 4)</p>
<p>Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.</p>			
Recherchenort DEN HAAG	Abschlußdatum der Recherche 09-07-1987	Prüfer GNUGESSER H. M.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmelde datum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)